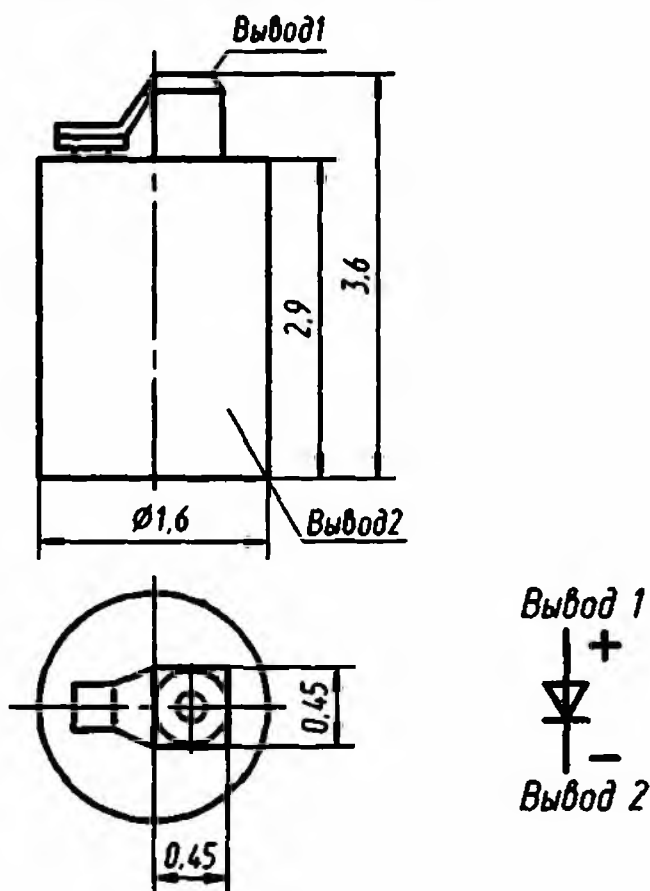


## ЗА735А-6, ЗА735Б-6, ЗА735В-6, ЗА735Г-6, ЗА735Д-6

Диоды арсенидгаллиевые, мезазпитаксиальные, на эффекте Ганна, генераторные. Предназначены для применения в генераторах сантиметрового диапазона длин волн герметизированной аппаратуры. Бескорпусные, с контактными площадками, на кристаллодержателе. Тип диода приводится на групповой таре.

Масса диода не более 0,1 г.

ЗА735(А-6.Б-6.В-6.Г-6.Д-6)



### Электрические параметры

Минимальная непрерывная выходная мощность в режиме генерации в рабочем диапазоне частот:

$T = -60 \dots -30 \text{ }^\circ\text{C}$ для ЗА735А-6, ЗА735Б-6, ЗА735В-6, ЗА735Г-6 .....	15 мВт
$T = -60 \dots 0 \text{ }^\circ\text{C}$ для ЗА735Д-6 .....	10 мВт
$T = -30 \dots -70 \text{ }^\circ\text{C}$ для ЗА735А-6, ЗА735Б-6, ЗА735В-6, ЗА735Г-6 .....	25 мВт
$T = +25 \text{ }^\circ\text{C}$ для ЗА735Д-6 .....	20 мВт
$T = 0 \dots +15 \text{ }^\circ\text{C}$ для ЗА735Д-6 .....	10 мВт

**Рабочий диапазон частот:**

3A735A-6 .....	4...4,5 ГГц
3A735B-6 .....	5,3...8,5 ГГц
3A735B-6 .....	8...12,5 ГГц
3A735Г-6 .....	11,7...18,5 ГГц
3A735Д-6 .....	8,15...17,85 ГГц

**Постоянный рабочий ток при  $T = +70...-60$  °С, не более:**

$U_{пр} = 13$ В для 3A735A-6 .....	0,6...0,7 А
$U_{пр} = 12$ В для 3A735B-6 .....	0,6...0,7 А
$U_{пр} = 10,2$ В для 3A735B-6 .....	0,7...0,8 А
$U_{пр} = 8,2$ В для 3A735Г-6 .....	0,7...0,8 А
$U_{пр} = 10,2$ В для 3A735Д-6 .....	0,7...0,8 А

**Сопротивление диода при  $I = 10$  мА:** **$T = -60$  °С:**

3A735A-6 .....	1,4...10 Ом
3A735B-6 .....	1,3...8 Ом
3A735B-6 .....	1,0...6 Ом
3A735Г-6 .....	0,6...5 Ом
3A735Д-6 .....	0,5...6 Ом

 **$T = +25$  °С:**

3A735A-6 .....	2...10 Ом
3A735B-6 .....	1,8...8 Ом
3A735B-6 .....	1,5...6 Ом
3A735Г-6 .....	1...5 Ом
3A735Д-6 .....	1...6 Ом

Индуктивность диода ..... 0,21...0,42 нГн

Емкость конструкции ..... 0,042...  
0,052 пФ**Предельные эксплуатационные данные****Постоянное напряжение:**

3A735A-6 .....	13,3 В
3A735B-6 .....	12,3 В
3A735B-6, 3A735Д-6 .....	10,5 В
3A735Г-6 .....	8,5 В

Температура кристаллодержателя ..... +85 °С

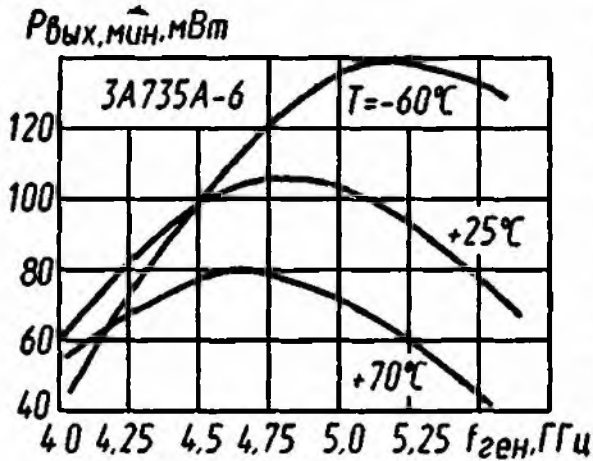
Температура окружающей среды ..... -60...+70 °С

Монтаж диодов производится методом прижима или пайкой. Прижимающее усилие к контактной площадке не более 150 г. Температура пайки к кристаллодержателю не более +160 °С. Время пайки не более 5 с, количество перепаяек не более 2.

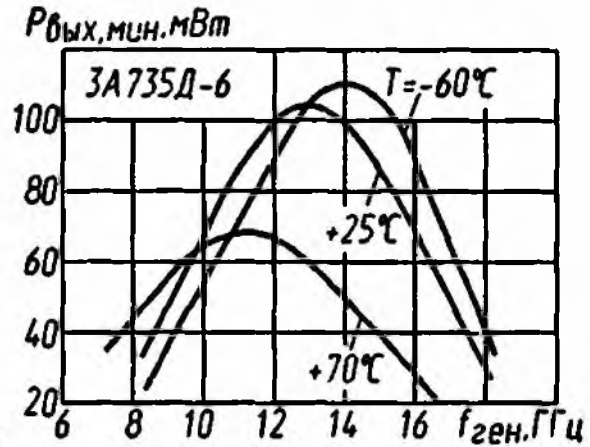
Защита диодов от статического электричества не требуется.

При  $T = -60...0$  °С работоспособность диода обеспечивается термостабилизацией температуры кристаллодержателя на уровне не менее +10 °С.

Значение рабочего тока указывается на индивидуальной таре.



Зависимости выходной мощности от частоты



Зависимости выходной мощности от частоты